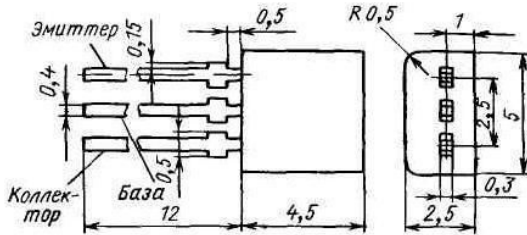


КТ373А, КТ373Б, КТ373В, КТ373Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные маломощные
Предназначены для работы в схемах переключения и усиления высокой частоты
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на корпусе
Масса транзистора не более 0,2 г



Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$:	
КТ373А	30 В
КТ373Б	25 В
КТ373В	10 В
КТ373Г	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	
	5 В
Постоянный ток коллектора	
	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 50 \text{ мкс}$, $Q \geq 500$	
	200 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения	
	100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 \div 328 \text{ К}$	
	150 мВт
Температура перехода	
	423 К
Температура окружающей среды	
	От 223 до 358 К

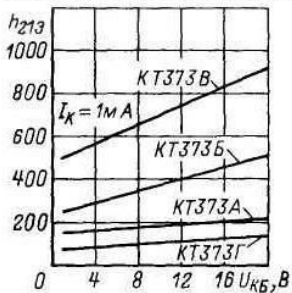
Примечания: 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 328 \div 358 \text{ К}$ определяется по формуле

$$P_{К \text{ макс}} = (423 - T)/0,61.$$

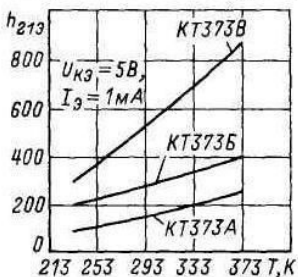
2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора.

Не рекомендуется работа транзисторов при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами.

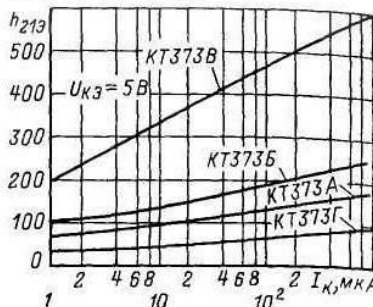
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора, радиус изгиба не менее 2 мм.



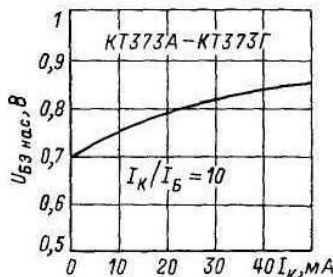
Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.

Электрические параметры

раничное напряжение при $I_3 = 5 \text{ мА}$ не менее

КТ373А, КТ373Г	25 В
КТ373Б	20 В
КТ373В	10 В
апряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10 \text{ мА}$, $I_б = 1 \text{ мА}$ не более	
	0,1 В
апряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10 \text{ мА}$, $I_б = 1 \text{ мА}$ не более	
	0,9 В
атический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 1 \text{ мА}$	

при $T = 298 \text{ К}$

КТ373А	100–250
КТ373Б	200–600
КТ373В	500–1000
КТ373Г	50–125

при $T = 358 \text{ К}$

КТ373А	100–750
КТ373Б	200–1800
КТ373В	500–3000
КТ373Г	50–375

при $T = 233 \text{ К}$

КТ373А	25–250
КТ373Б	50–600
КТ373В	125–1000
КТ373Г	12–125

одуль коэффициента передачи тока при $f = 100 \text{ МГц}$, $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 1 \text{ мА}$ не менее

стоянная времени цепи обратной связи при $f = 5 \text{ МГц}$, $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_к = 1 \text{ мА}$ не более

КТ373А, КТ373Г	200 пс
КТ373Б	300 пс
КТ373В	700 пс

кость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$ не более

ратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КЭ \text{ макс}}$

при $T = 298 \text{ К}$

при $T = 358 \text{ К}$

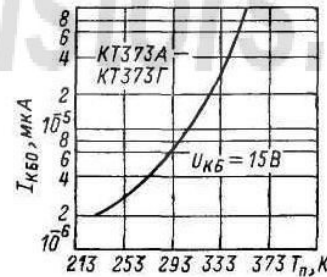
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс}}$

не более:

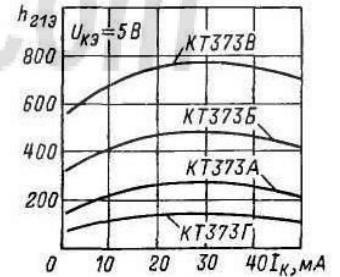
КТ373А, КТ373Б, КТ373В

КТ373Г

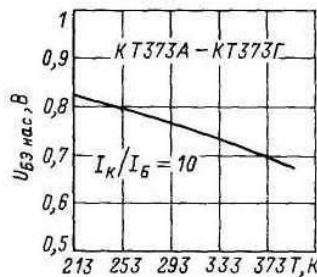
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5 \text{ В}$ не более



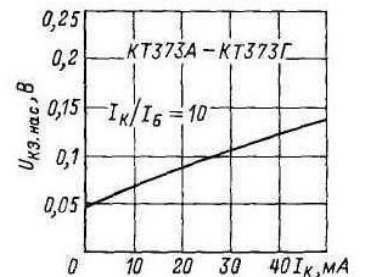
Зависимость обратного тока коллектора от температуры перехода.



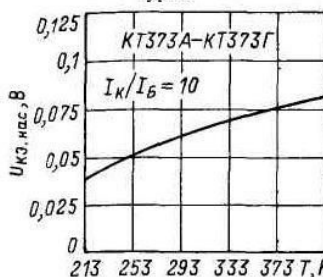
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



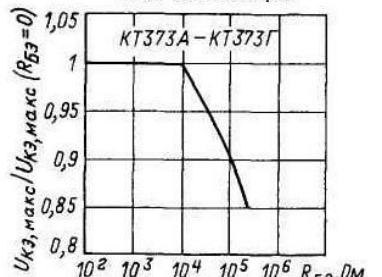
ависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зависимость относительно максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.